

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ
24 мая с 10:00 до 18:00 часов (присутствие с 13:30 до 14:30)

1	Васильченко Александр Анатольевич	Квазидвумерная электронно-дырочная жидкость с двумя типами дырок в квантовых ямах SiGe/Si.
2	Рубан Олег Альбертович	Частотные характеристики нитрид-галлиевых полевых транзисторов со структурной релаксацией барьерного слоя.
3	Зебрев Геннадий Иванович	Особенности подпороговой проводимости МОП транзисторов при низких температурах.
4	Неженцев Алексей Викторович	Исследование омических контактов к наногетероструктурам на основе арсенида галлия.
5	Жилинский Валерий Викторович	Синтез наноструктурированных мультикомпонентных металлооксидов в матрицах анодного оксида алюминия.
6	Нигериш Кирилл Анатольевич	Исследование техники термического оплавления фоторезиста.
7	Чеботарев Сергей Николаевич	Закономерности временной устойчивости и пространственной направленности ионно-лучевого распыления InAs и GaAs, используемого для получения оптоэлектронных наноструктур.
8	Смирницкий Николай Сергеевич	Соединение диэлектрических материалов под действием электрического поля.
9	Гольпяпин Ярослав Валерьевич	Влияние органических молекул лигандов различной длины на оптические свойства конденсатов квантовых точек PbS.
10	Александров Алексей Евгеньевич	Исследование фотопроводимости пленок квантовых точек PbS с различными лигандами.
11	Гордейчук Марк Вячеславович	Структурная изомеризация кремниевого призмана Si ₁₉ H ₁₂ .
12	Катин Константин Петрович	Структурные и энергетические свойства допированных азотом фуллеренов.
13	Маслов Михаил Михайлович	Двумерные ковалентные комплексы на основе молекулы CL-20.
14	Торхов Николай Анатольевич	Наноразмерные свойства химического окисла p+-GaAs{100}.
15	Васильев Роман Борисович	Синтез, структура и свойства сверхтонких квазидвумерных нанопластинок CdSe и гетероструктур на их основе.
16	Шарков Андрей Иванович	Анизотропия рассеяния поверхностных акустических волн когерентными границами двойников в кристаллах CdZnTe.
17	Торхов Николай Анатольевич	Методы атомно-силовой микроскопии для контроля качества p++-n-GaAs переходов.
18	Зотов Артём Олегович	Особенности формирования сверхтонкой пленки W ₂ C для проводящих зондов атомно-силовой микроскопии.
19	Матющенко Илья Александрович	Анализ влияния ионно-кластерной обработки на состояние поверхности оптической стеклокерамики методом фликкер-шумовой спектроскопии.
20	Большакова Инесса Антоновна	Влияние облучения нейтронами на параметры холловских сенсоров на основе нанопленок молибдена.

21	Богданов Евгений Владимирович	Температурные и деформационные зависимости длины волны и поляризации излучения лазерных диодов на основе n-AlGaAs/GaAsP/p-AlGaAs.
22	Кожанов Александр Евгеньевич	Распространение прямых объемных магнитоэлектрических спиновых волн в структурированных пленках магнетиков.
23	Махиборода Александр Васильевич	Базовая технология построения коммутационной среды для высокопараллельных вычислительных систем.
24	Шарков Андрей Иванович	Особенности отражения потока когерентных фононов в упруго – напряжённых наноструктурах на основе SiGe.
25	Бакун Алексей Дмитриевич	Разработка МЭМС-устройств на основе многослойных мембранных конструкций.
26	Султанов Азрет Оюсович	Исследование карбидизированного пористого кремния методом рамановской спектроскопии.
27	Минкин Вадим Сергеевич	Теоретическое обоснование и практическое использование концепции зонного инжиниринга при проектировании устройств генерации электромагнитного излучения на основе мультибарьерных гетероструктур GaAs/GaAlAs.
28	Бакеренков Александр Сергеевич	Влияние смещения эмиттерного перехода на темп радиационной деградации биполярных SiGe-транзисторов.